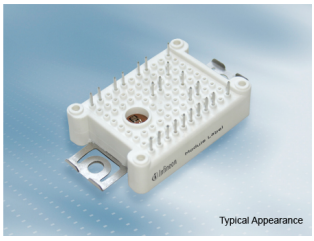
Final datasheet

EasyPIM™ 模块 采用第七代沟槽栅/场终止 IGBT7 和第七代发射极控制二极管 带有温度检测 NTC



特性

- 电气特性
  - V_{CES} = 1200 V
  - $I_{C\ nom}$ = 10 A / I_{CRM} = 20 A
  - 低 V_{CEsat}
  - 过载操作达 175°C
  - 沟槽栅 IGBT7
- 机械特性
  - 焊接技术
  - 紧凑型设计
  - 高功率密度
  - 低热阻的三氧化二铝 Al_2O_3 衬底
  - 2.5 kV 交流 1 分钟 绝缘

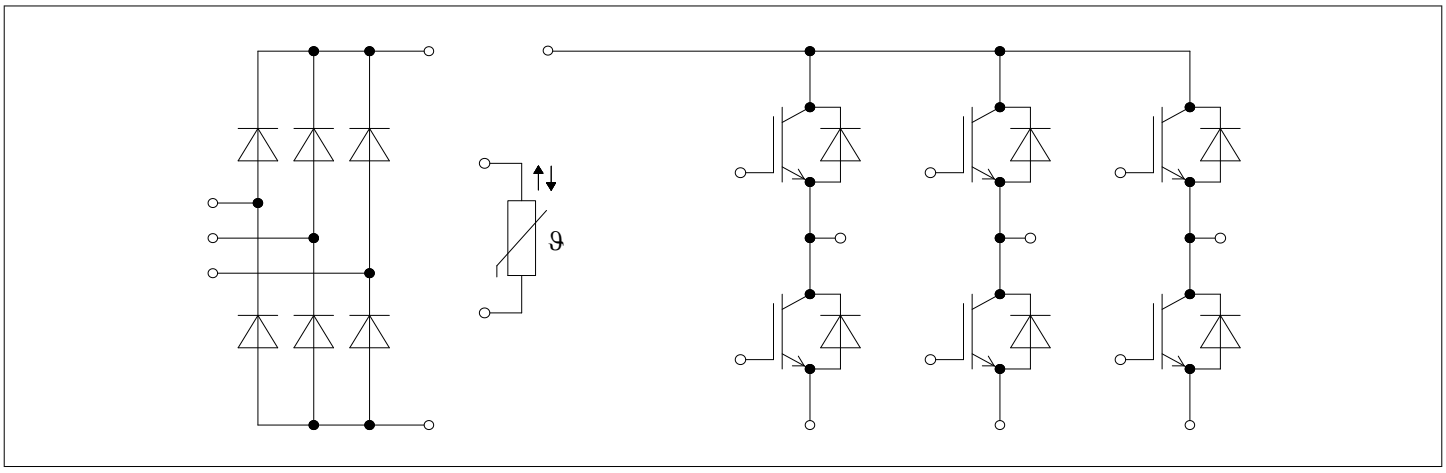
可选应用

- 空调
- 辅助逆变器
- 电机传动

产品认证

- 根据 IEC 60747、60749 和 60068 标准的相关测试，符合工业应用的要求。

描述



内容

描述 1
特性 1
可选应用 1
产品认证 1
内容 2
1 封装 3
2 **IGBT,** 逆变器 3
3 二极管,逆变器 5
4 二极管,整流器 6
5 负温度系数热敏电阻 6
6 特征参数图表 7
7 电路拓扑图 12
8 封装尺寸 13
9 模块标签代码 14
修订历史 15
免责声明 16

1 封装

表 1 绝缘参数

特征参数	代号	标注或测试条件	数值	单位
绝缘测试电压	V_{ISOL}	RMS, f = 50 Hz, *t* = 1 min	2.5	kV
内部绝缘		基本绝缘 (class 1, IEC 61140)	Al_2O_3	
相对电痕指数	*CTI*		> 200	
相对温度指数 (电)	*RTI*	封装	140	°C

表 2 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
杂散电感,模块	L_{sCE}			30		nH
模块引线电阻,端子-芯片	$R_{AA'+CC'}$	T_H = 25 °C, 每个开关		6		mΩ
模块引线电阻,端子-芯片	$R_{CC'+EE'}$	T_H = 25 °C, 每个开关		8		mΩ
储存温度	T_{stg}		-40		125	°C
Mounting force per clamp	*F*		20		50	N
重量	*G*			24		g

注: The current under continuous operation is limited to 30A rms per connector pin.

2 IGBT, 逆变器

表 3 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
集电极－发射极电压	V_{CES}		T_{vj} = 25 °C	1200	V
连续集电极直流电流	I_{CDC}	$T_{vj\,max}$ = 175 °C	T_H = 125 °C	10	A
集电极重复峰值电流	I_{CRM}	t_p 受限于 $T_{vj\,op}$		20	A
栅极－发射极峰值电压	V_{GES}			±20	V

表 4 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
集电极－发射极饱和电压	$V_{CE\,sat}$	I_C = 10 A, V_{GE} = 15 V	T_{vj} = 25 °C		1.60	1.85	V
			T_{vj} = 125 °C		1.74		
			T_{vj} = 175 °C		1.82		
栅极阈值电压	V_{GEth}	I_C = 0.22 mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25 °C		5.15	5.8	6.45	V

(待续)

表 4　　(续) 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
栅极电荷	Q_G	V_{GE} = ±15 V, V_{CC} = 600 V			0.157		µC
内部栅极电阻	R_{Gint}	T_{vj} = 25 °C			0.0		Ω
输入电容	C_{ies}	f = 100 kHz, T_{vj} = 25 °C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V			1.89		nF
反向传输电容	C_{res}	f = 100 kHz, T_{vj} = 25 °C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V			0.007		nF
集电极-发射极截止电流	I_{CES}	V_{CE} = 1200 V, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C			0.0045	mA
栅极-发射极漏电流	I_{GES}	V_{CE} = 0 V, V_{GE} = 20 V, T_{vj} = 25 °C				100	nA
开通延迟时间(感性负载)	t_{don}	I_C = 10 A, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 8.2 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.023		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.025		
			T_{vj} = 175 °C		0.026		
上升时间(感性负载)	t_r	I_C = 10 A, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 8.2 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.014		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.017		
			T_{vj} = 175 °C		0.019		
关断延迟时间(感性负载)	t_{doff}	I_C = 10 A, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 8.2 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.124		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.157		
			T_{vj} = 175 °C		0.176		
下降时间(感性负载)	t_f	I_C = 10 A, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 8.2 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.227		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.347		
			T_{vj} = 175 °C		0.422		
开通损耗能量 (每脉冲)	E_{on}	I_C = 10 A, V_{CC} = 600 V, L_σ = 35 nH, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 8.2 Ω, di/dt = 550 A/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		0.73		mJ
			T_{vj} = 125 °C		0.94		
			T_{vj} = 175 °C		1.13		
关断损耗能量 (每脉冲)	E_{off}	I_C = 10 A, V_{CC} = 600 V, L_σ = 35 nH, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 8.2 Ω, dv/dt = 2700 V/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		0.623		mJ
			T_{vj} = 125 °C		0.97		
			T_{vj} = 175 °C		1.17		
短路数据	I_{SC}	$V_{GE} \leq$ 15 V, V_{CC} = 800 V, V_{CEmax}=V_{CES}-L_{sCE}*di/dt	$t_P \leq$ 8 µs, T_{vj}=150 °C		32		A
			$t_P \leq$ 7 µs, T_{vj}=175 °C		30		
结－散热器热阻	R_{thJH}	每个 IGBT, λ_{grease} = 4.3 W/(m·K)			1.83		K/W
允许开关的温度范围	$T_{vj\,op}$			-40		175	°C

注: *$T_{vj\,op}$ > 150°C is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.*

3 二极管,逆变器

表 5 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}		T_{vj} = 25 °C	1200	V
连续正向直流电流	I_F			10	A
正向重复峰值电流	I_{FRM}	t_P = 1 ms		20	A
I2t-值	I^2t	t_P = 10 ms, V_R = 0 V	T_{vj} = 125 °C	27.5	A^2s
			T_{vj} = 175 °C	24	

表 6 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
正向电压	V_F	I_F = 10 A, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		1.72	2.10	V
			T_{vj} = 125 °C		1.59		
			T_{vj} = 175 °C		1.52		
反向恢复峰值电流	I_{RM}	V_{CC} = 600 V, I_F = 10 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 550 A/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		10.5		A
			T_{vj} = 125 °C		15.3		
			T_{vj} = 175 °C		17.5		
恢复电荷	Q_r	V_{CC} = 600 V, I_F = 10 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 550 A/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		0.97		µC
			T_{vj} = 125 °C		1.7		
			T_{vj} = 175 °C		2.2		
反向恢复损耗（每脉冲）	E_{rec}	V_{CC} = 600 V, I_F = 10 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 550 A/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		0.24		mJ
			T_{vj} = 125 °C		0.51		
			T_{vj} = 175 °C		0.72		
结－散热器热阻	R_{thJH}	每个二极管, λ_{grease} = 4.3 W/(m·K)			2.50		K/W
允许开关的温度范围	$T_{vj\,op}$			-40		175	°C

注: *$T_{vj\,op}$ > 150°C is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.*

4 二极管,整流器

表 7 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}		T_{vj} = 25 °C	1600	V
最大正向均方根电流(每芯片)	I_{FRMSM}	T_H = 100 °C		25	A
最大整流器输出均方根电流	I_{RMSM}	T_H = 100 °C		25	A
正向浪涌电流	I_{FSM}	t_P = 10 ms	T_{vj} = 25 °C	300	A
			T_{vj} = 150 °C	245	
I2t-值	I^2t	t_P = 10 ms	T_{vj} = 25 °C	450	A^2s
			T_{vj} = 150 °C	300	

表 8 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
正向电压	V_F	I_F = 10 A	T_{vj} = 150 °C		0.80		V
反向电流	I_r	T_{vj} = 150 °C, V_R = 1600 V			1		mA
结一散热器热阻	R_{thJH}	每个二极管, λ_{grease} = 4.3 W/(m·K)			1.50		K/W
允许开关的温度范围	$T_{vj, op}$			-40		150	°C

5 负温度系数热敏电阻

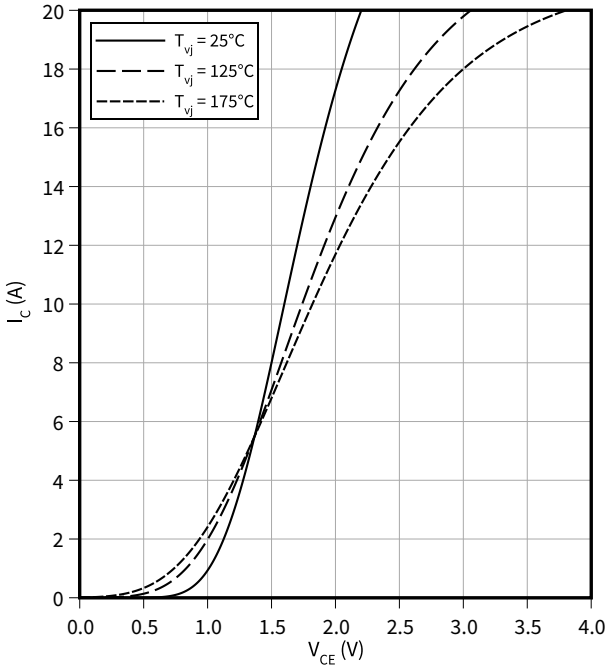
表 9 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
额定电阻值	R_{25}	T_{NTC} = 25 °C		5		kΩ
R_{100} 偏差	$\Delta R/R$	T_{NTC} = 100 °C, R_{100} = 493 Ω	-5		5	%
耗散功率	P_{25}	T_{NTC} = 25 °C			20	mW
B-值	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2-1/(298{,}15\ K))]$		3375		K
B-值	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2-1/(298{,}15\ K))]$		3411		K
B-值	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2-1/(298{,}15\ K))]$		3433		K

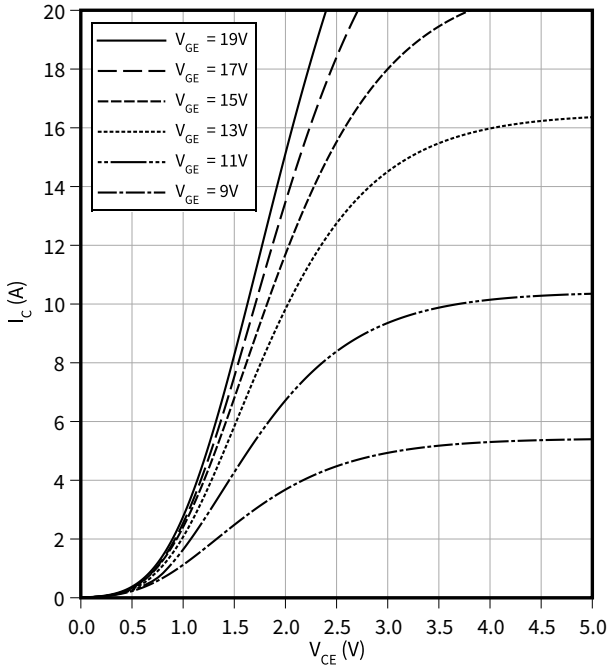
注: 根据应用手册标定

6 特征参数图表

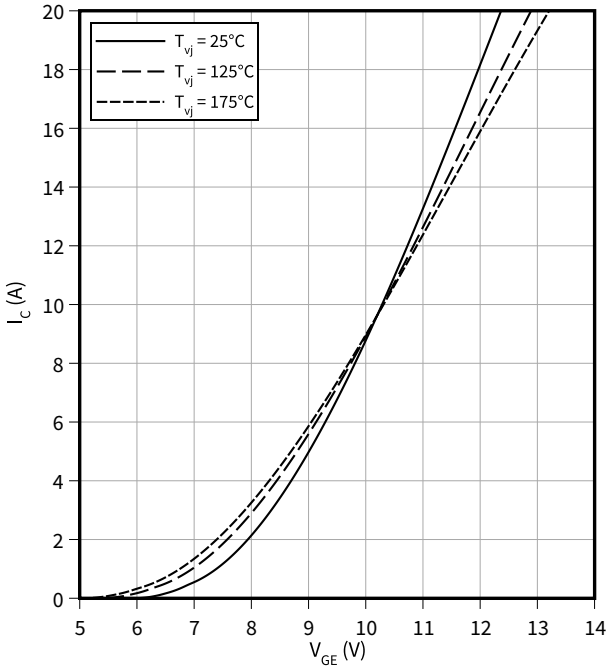
输出特性 （典型), IGBT, 逆变器
$I_C = f(V_{CE})$
V_{GE} = 15 V



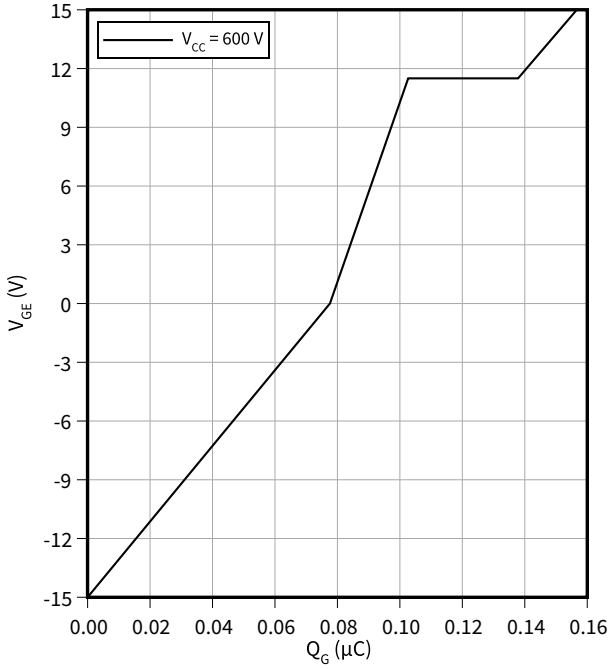
输出特性（典型), IGBT, 逆变器
$I_C = f(V_{CE})$
T_{vj} = 175 °C



传输特性 （典型), IGBT, 逆变器
$I_C = f(V_{GE})$
V_{CE} = 20 V



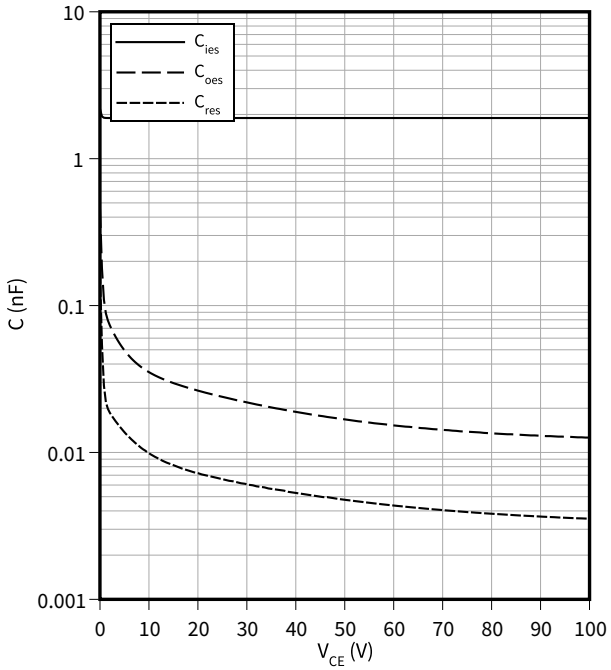
栅极电荷特性 （典型), IGBT, 逆变器
$V_{GE} = f(Q_G)$
I_C = 10 A, T_{vj} = 25 °C



电容特性 （典型), IGBT, 逆变器

$C = f(V_{CE})$

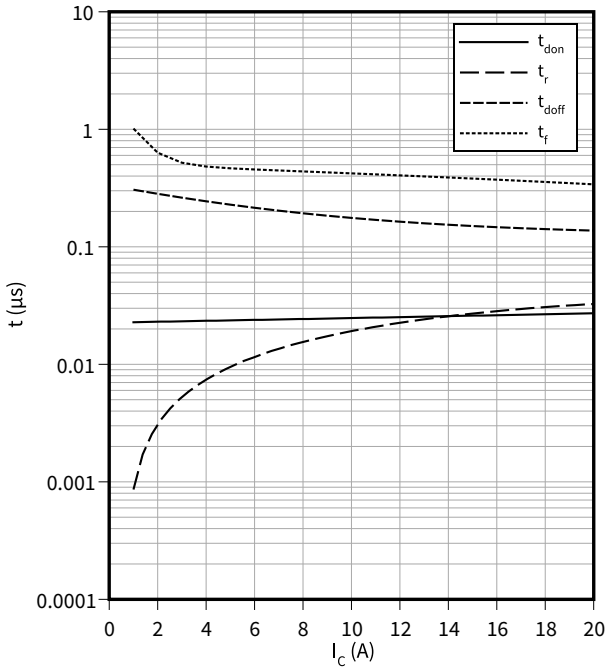
$f = 100\ kHz, V_{GE} = 0\ V, T_{vj} = 25\ °C$



开关时间 （典型), IGBT, 逆变器

$t = f(I_C)$

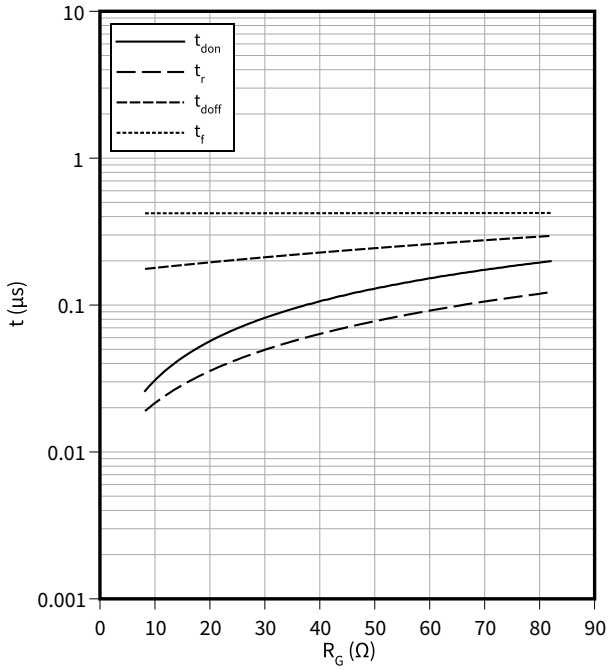
$R_{Goff} = 8.2\ \Omega, R_{Gon} = 8.2\ \Omega, V_{CC} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, T_{vj} = 175\ °C$



开关时间 （典型), IGBT, 逆变器

$t = f(R_G)$

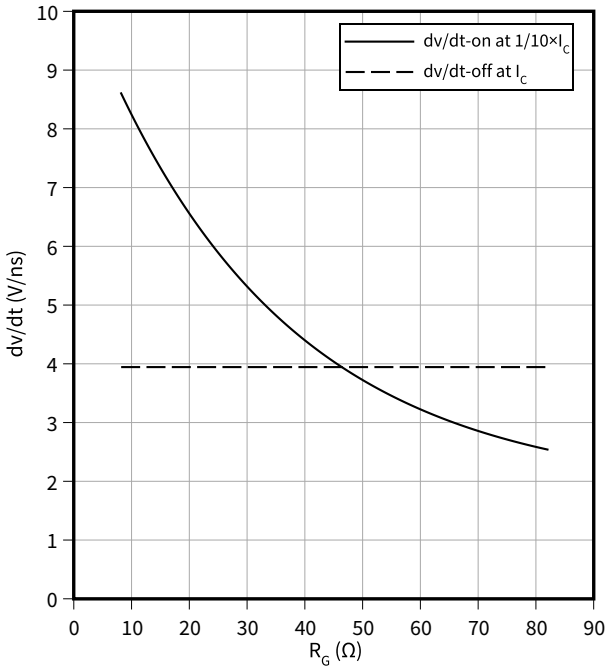
$I_C = 10\ A, V_{CC} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, T_{vj} = 175\ °C$



电压变化斜率 （典型), IGBT, 逆变器

$dv/dt = f(R_G)$

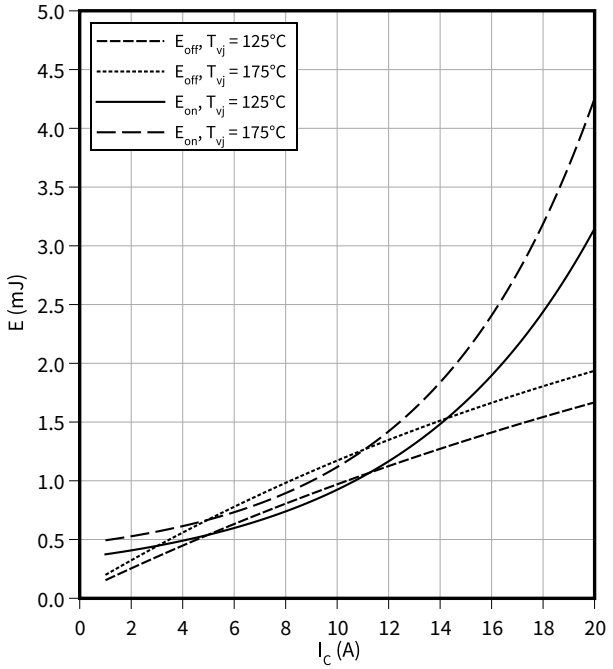
$I_C = 10\ A, V_{CC} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, T_{vj} = 25\ °C$



开关损耗 （典型), IGBT, 逆变器

$E = f(I_C)$

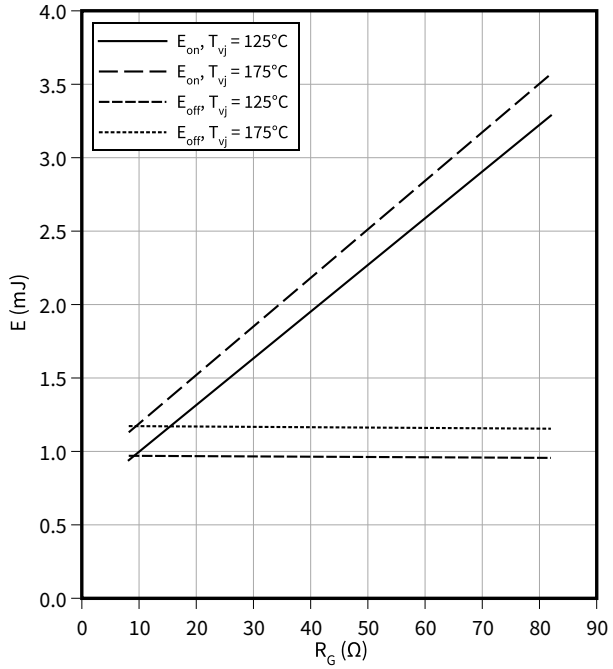
$R_{Goff} = 8.2\ \Omega$, $R_{Gon} = 8.2\ \Omega$, $V_{CC} = 600$ V, $V_{GE} = \pm 15$ V



开关损耗 （典型), IGBT, 逆变器

$E = f(R_G)$

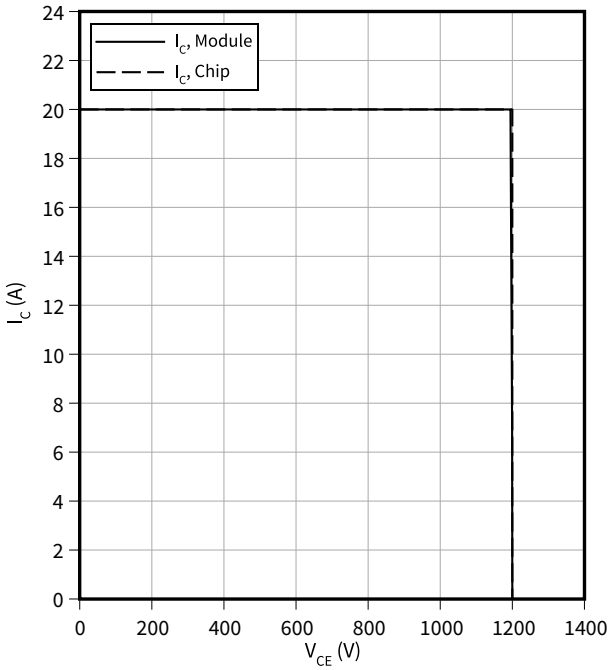
$I_C = 10$ A, $V_{CC} = 600$ V, $V_{GE} = \pm 15$ V



反偏安全工作区 （RBSOA）, IGBT, 逆变器

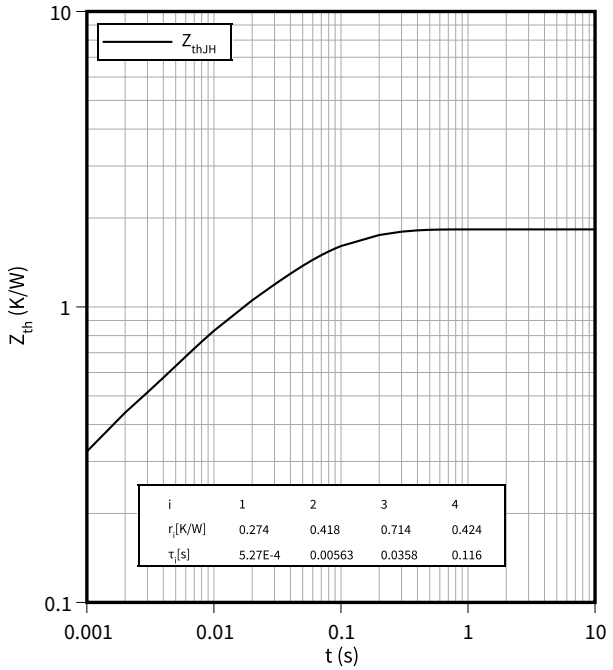
$I_C = f(V_{CE})$

$V_{GE} = \pm 15$ V, $T_{vj} = 175$ °C, $R_{Goff} = 8.2\ \Omega$



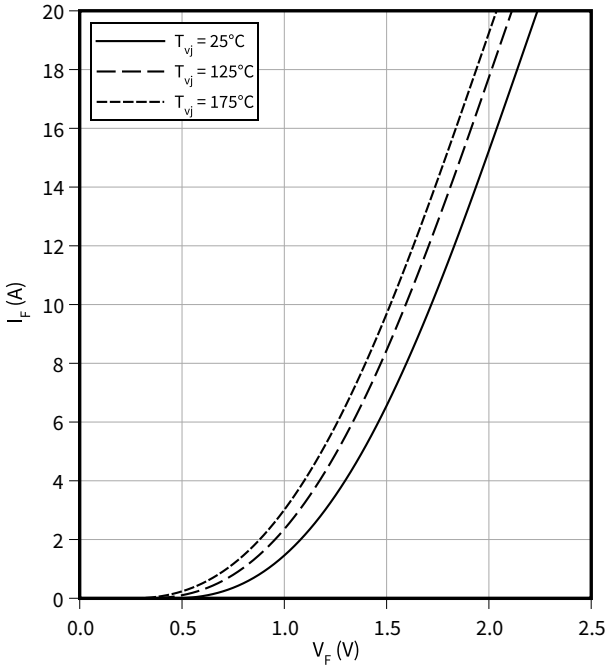
瞬态热阻抗, IGBT, 逆变器

$Z_{th} = f(t)$



正向特性 （典型), 二极管,逆变器

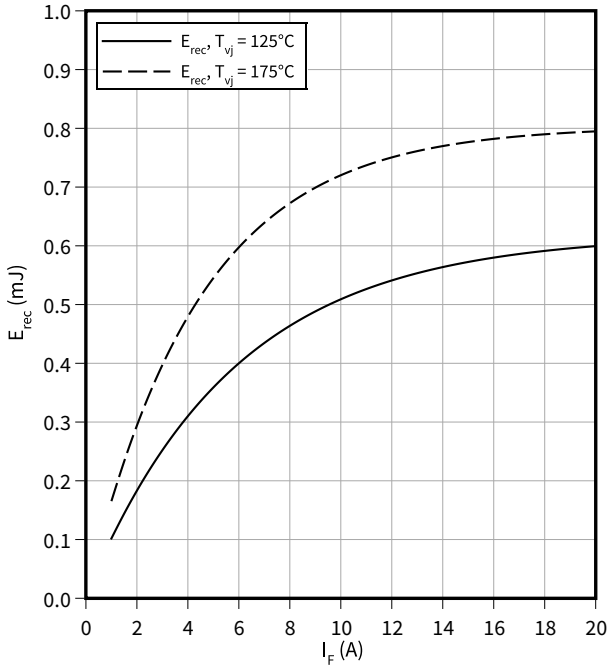
$I_F = f(V_F)$



开关损耗 （典型), 二极管,逆变器

$E_{rec} = f(I_F)$

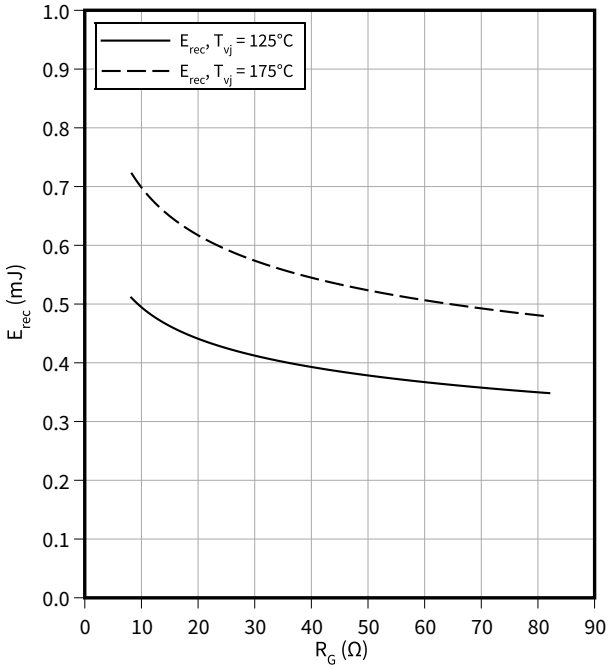
$R_{Gon} = 8.2\ \Omega$, $V_{CC} = 600$ V



开关损耗 （典型), 二极管,逆变器

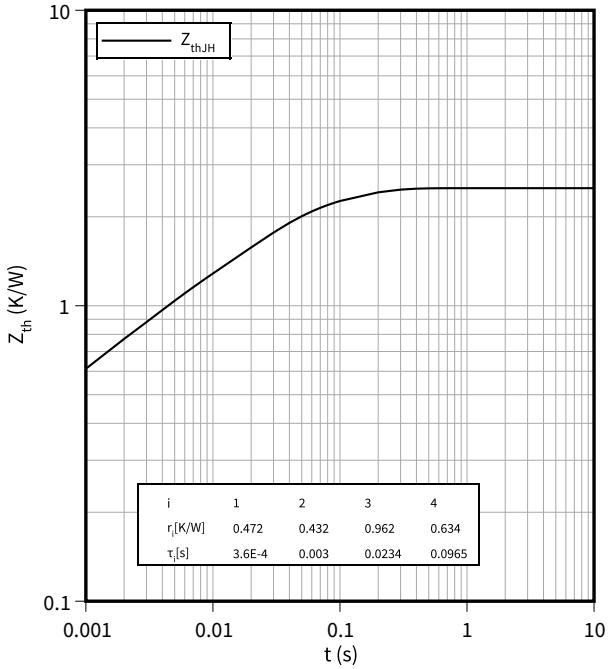
$E_{rec} = f(R_G)$

$I_F = 10$ A, $V_{CC} = 600$ V

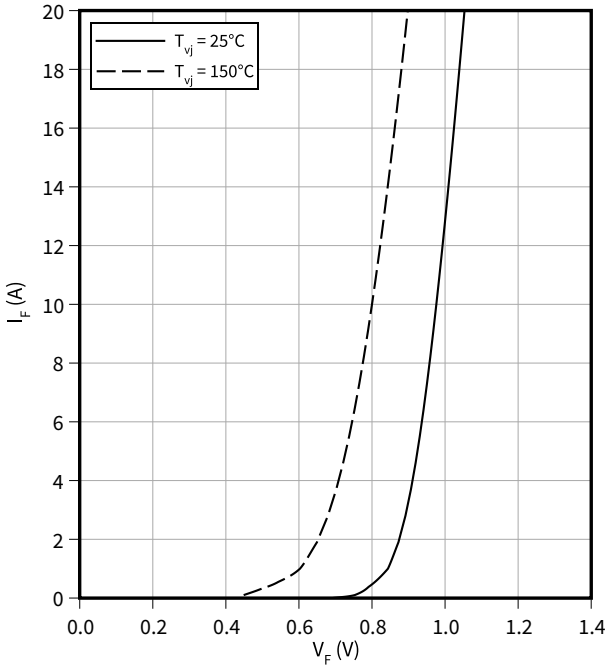


瞬态热阻抗, 二极管,逆变器

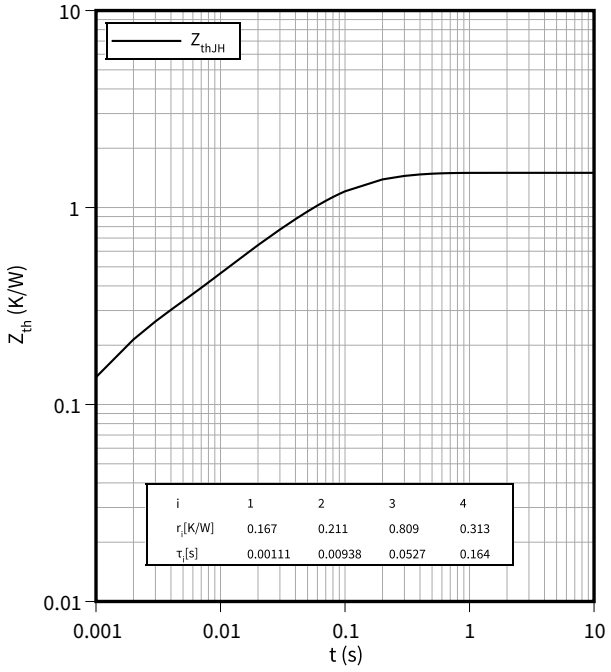
$Z_{th} = f(t)$



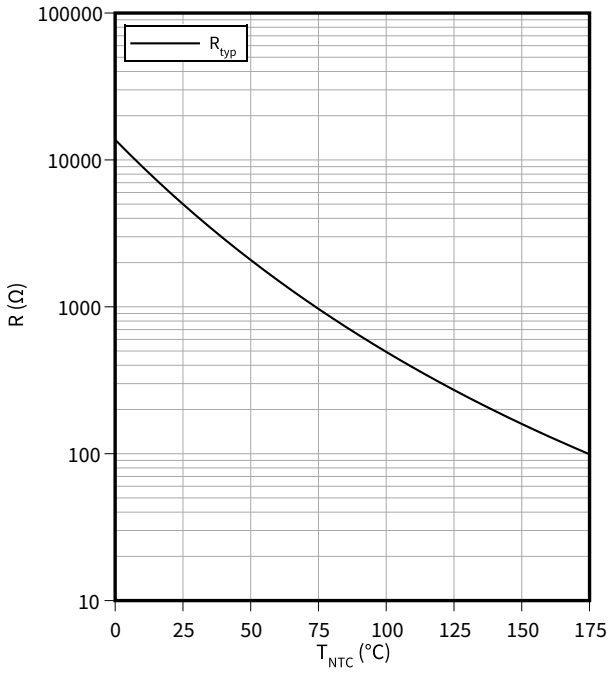
正向特性 （典型), 二极管,整流器
$I_F = f(V_F)$



瞬态热阻抗, 二极管,整流器
$Z_{th} = f(t)$



温度特性, 负温度系数热敏电阻
$R = f(T_{NTC})$



7 电路拓扑图

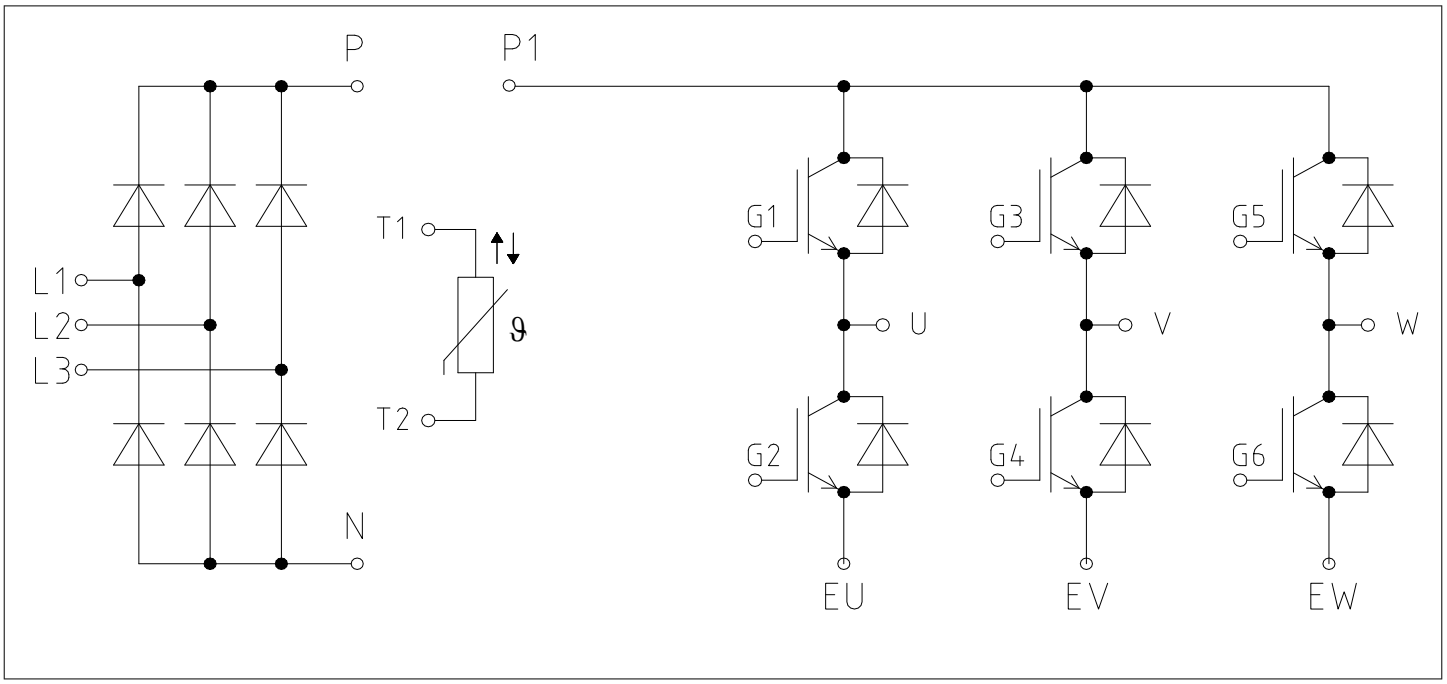


图 1

8 封装尺寸

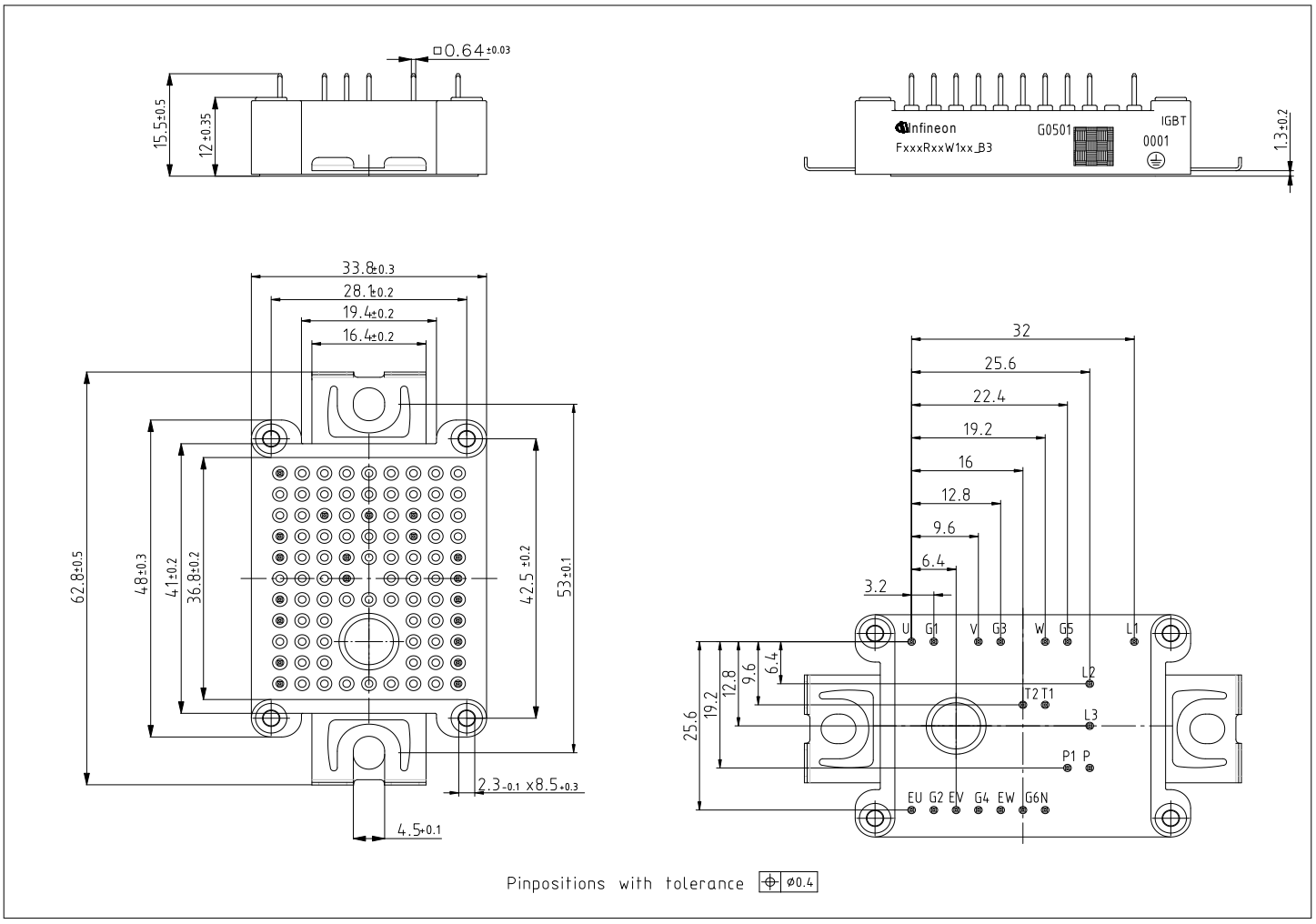

□0.64 ±0.03
15.5±0.5
12±0.35
Infineon
FxxxRxxW1xx_B3
G0501
IGBT
0001
1.3±0.2
33.8±0.3
28.1±0.2
19.4±0.2
16.4±0.2
62.8±0.5
48±0.3
41±0.2
36.8±0.2
42.5±0.2
53±0.1
2.3-0.1 x8.5+0.3
4.5+0.1
32
25.6
22.4
19.2
16
12.8
9.6
6.4
3.2
U G1 V G3 W G5 L1
L2
T2 T1
L3
P1 P
EU G2 EV G4 EW G6N
Pinpositions with tolerance ⌖ ø0.4

图 2

9 模块标签代码

Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	*Content* Module serial number Module material number Production order number Date code (production year) Date code (production week)	*Digit* 1 –5 6 - 11 12 - 19 20 –21 22 –23	*Example* 71549 142846 55054991 15 30
Example	7154914284655054991530		7154914284655054991530

图 3

修订历史

修订版本	发布日期	变更说明
V1.0	2018-11-30	Target datasheet
V2.0	2020-02-14	Preliminary datasheet
n/a	2020-09-01	Datasheet migrated to a new system with a new layout and new revision number schema: target or preliminary datasheet = 0.xy; final datasheet = 1.xy
0.10	2021-03-16	
1.00	2025-07-18	Final datasheet

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2025-07-18

Published by

Infineon Technologies AG

81726 Munich, Germany

© 2025 Infineon Technologies AG

All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-AAY103-004

重要提示

本文档所提供的任何信息绝不应当被视为针对任何 条件或者品质而做出的保证（质量保证）。

英飞凌对于本文档中所提及的任何事例、提示或者 任何特定数值及/或任何关于产品应用方面的信息均 在此明确声明其不承担任何保证或者责任，包括但 不限于其不侵犯任何第三方知识产权的保证均在此 排除。

此外，本文档所提供的任何信息均取决于客户履行 本文档所载明的义务和客户遵守适用于客户产品以 及与客户对于英飞凌产品的应用所相关的任何法律 要求、规范和标准。

本文档所含的数据仅供经过专业技术培训的人员使用。客户自身的技术部门有义务对于产品是否适宜 于其预期的应用和针对该等应用而言本文档中所提 供的信息是否充分自行予以评估。

警告事项

由于技术所需产品可能含有危险物质。如需了解该 等物质的类型，请向离您最近的英飞凌科技办公室 接洽。

除非由经英飞凌科技授权代表签署的书面文件中做 出另行明确批准的情况外，英飞凌科技的产品不应 当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后 当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后 领域。